

財團法人工業技術研究院 函

地址：31057 新竹縣竹東鎮中興路 4 段 195 號

承辦人：林秀姿

電話：03-5916636

傳真：03-5820466

E-mail：iris.lin@itri.org.tw



108000129915

24159 三重區重新路五段 609 巷 14 號 9 樓之 3

受文者：台灣區照明燈具輸出業同業公會(TLFEA)

發文日期：中華民國 108 年 01 月 23 日

發文字號：工研轉字第 1080001299 號

速別：普通件

密等：無

附件：如文

主旨：為本院「影像、半導體技術及平面顯示器等相關專利讓與案」公開招標事，敬請轉知 貴會會員等相關廠商重要資訊，把握機會參與本活動，請 查照。

說明：

- 一、為提昇國內廠商智財防護能力，本院將辦理影像、半導體技術及平面顯示器等相關專利 154 案 288 件之讓與公開招標活動(詳如附件)。
- 二、本案 154 案 288 件專利共分為七個類別：(一)電容觸控技術(6 案 12 件)、(二)影像技術(23 案 37 件)、(三)半導體元件技術(29 案 33 件)、(四)半導體封裝技術(15 案 36 件)、(五)半導體光源技術(18 案 37 件)、(六)平面顯示器之有機發光顯示技術(32 案 68 件)及(七)平面顯示器之薄膜電晶體技術(31 案 65 件)。
- 三、有關本活動詳細資訊，請參考下列網站公告：
(一)工研院研發成果公告網站 (<https://www.itri.org.tw/chi/Content/Bulletin/list.aspx?&SiteID=1&MmmID=3000&SY=0&CatID=1>)

照明燈具公會
收文第 108071 號
108 年 1 月 25 日 呈 午

(二) 台灣技術交易資訊網 (<https://www.twtm.com.tw/Web/news/trans.aspx>)。

四、本案截標日為 108 年 2 月 22 日，開標日為 108 年 2 月 25 日。

五、公開說明會：

(一) 舉辦時間：民國（下同）108 年 2 月 15 日 14 時至 15 時。

(二) 舉辦地點：新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 108 室。

(三) 報名須知：採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 108 年 2 月 14 日中午 12 時整（含）前發送電子郵件（主旨上註明「影像、半導體技術及平面顯示器等相關專利讓與案公開說明會報名」，並於內文中陳明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱。）向本案聯絡人報名。聯絡人將於 108 年 2 月 14 日下午 5 時整（含）前發送電子郵件回覆並告知公開說明會會議資訊。

六、本案聯絡人：

工研院技術移轉與法律中心 林小姐

電話：(03) 591-6636


傳真：(03) 582-0466

電子信箱：iris.lin@itri.org.tw

地址：31057 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室

正本受文者：台灣區照明燈具輸出業同業公會(TLFEA)

院長



依權責劃分規定授權業務主管決行

工業技術研究院

影像、半導體技術及平面顯示器等相關專利讓與案

有鑑於企業在面對市場、技術、產品的激烈競爭時，掌握優質專利可形成強有力的防護網，並可藉此累積競爭能力，成為企業在國際間競爭的最佳籌碼。財團法人工業技術研究院擬將其所擁有之優質專利，以讓與之方式提供國內廠商，以增加廠商國際競爭力，促進整體產業發展及提升研發成果運用效益。

一、主辦單位：財團法人工業技術研究院（以下簡稱「工研院」）

二、投標廠商資格：

國內依中華民國法令組織登記成立且從事研發、設計、製造或銷售之公司法人。

三、讓與標的：

本讓與案包含影像、半導體技術及平面顯示器等相關專利 154 案 288 件之工研院應有部分(以下簡稱「讓與標的」)。「讓與標的」中之案次 49、92、94、99~112、115~120、125~142、144~145、147~154 係與第三人共有(以下簡稱「共有標的」)。部分「讓與標的」為科專成果，部分屬工研院自有成果。詳細情形請參「附件：讓與標的清單」。

「讓與標的」相關資訊詳如附件或請參考台灣技術交易資訊網 (<https://www.twtm.com.tw/Web/index.aspx>)、及工研院研發成果公告網站 (<https://www.itri.org.tw/chi/Content/Bulletin/list.aspx?&SiteID=1&MmmID=3000&SY=0&CatID=1>)。

四、公開說明會與領標：

1. 公開說明會將於民國（下同）108 年 2 月 15 日 14 時整於工研院中興院區 51 館 108 室舉辦。
2. 公開說明會採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 108 年 2 月 14 日中午 12 時整（含）前發送電子郵件（請於電子郵件主旨上註明「影像、半導體技術及平面顯示器等相關專利讓與案公開說明會報名」，並請於電子郵件內文中陳明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱。）予工研院技術移轉與法律中心（以下簡稱「技轉法律中心」）聯絡人（請詳十三、聯絡方式）進行報名。工研院「技轉法律中心」聯絡人將於 108 年 2 月 14 日下午 5 時整（含）前發送電子郵件回覆並告知公開說明會會議資訊。
3. 自本標案公告日起至截標日 108 年 2 月 22 日下午 5 時整(含)止，得洽「技轉法律中心」聯絡人領取標單。

五、投標方法：

1. 本標案採通訊或親送方式投標。投標廠商應按投標單內所列各項目填

寫清楚，加蓋投標廠商公司章及負責人章，連同押標金、公司設立證明文件（如營利事業登記證、公司設立核准函、公司登記/變更資料或公司設立登記表影本）、廠商基本資料表(以下統稱「投標文件」)，裝入信封密封之，並在信封上註明「人機介面相關專利讓與案」，於截標日 108 年 2 月 22 日下午 5 時整（含）前（以送達收據為憑）掛號寄達或親送至：

31057 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室

工研院技轉法律中心 林小姐 收

2. 本標案採「案」方式投標。「讓與標的」以同一發明為一案。本標案採一案一標，即同一案專利不分開投標/開標。
3. 本標案不得共同投標或重複投標。
4. 投標後除工研院要求或同意外，投標廠商不得以任何理由撤回或修改其投標單。
5. 投標廠商於投標時，不得附加任何條件。

六、重要事項：

請投標人注意：「共有標的」係與第三人共有。故，「共有標的」之讓與，須經共有人同意後，始生效力。

七、押標金：

1. 押標金為總投標金額之 10%，以仟元為最小單位，以下四捨五入。
2. 押標金應以現金、銀行本票或即期支票支付。若以銀行本票或即期支票支付時，請註明受款人為「財團法人工業技術研究院」，並載明禁止背書轉讓。
3. 得標廠商之押標金移充簽約保證金；未得標廠商之押標金，於開標後掛號無息寄回投標廠商。

八、有下列情形之一者，應認為無效投標，無效之投標不進入決標程序：

1. 投標時間截止後之投標。
2. 開標前業已公告停止本標案交易程序。
3. 投標廠商共同投標或重複投標，全部投標均為無效。
4. 投標單附加任何成交條件者。
5. 投標文件之記載不符所定程式或其記載之字跡潦草、模糊，致無法辨識者。
6. 投標文件有所缺漏者。但押標金不足者，工研院得要求投標廠商補足，若於決標前未能補足者，其投標為無效。

九、決標方法：

1. 開標日為 108 年 2 月 25 日(開標時間及地點另行通知投標廠商)。
2. 開標時，先就投標資格、投標單、押標金、公司設立證明文件、廠商基本資料表進行審查及確認。

3. 同一案以投標廠商出價金額最高且高於底價者得標。同一案有二家（含）以上投標金額相同時，由工研院現場抽籤決之。
4. 開標時將請律師到場監標。
5. 開標後將個別通知投標廠商開標結果（不公告得標廠商）。
6. 對於流標、廢標或無效投標之「讓與標的」，工研院得逕洽第三人為授權或讓與等交易行為，第三人不限於本公告之投標廠商資格。

十、契約事項：

1. 得標廠商應於接獲得標通知起 30 個工作天內，與工研院簽訂「讓與契約書」。各項契約條件應以工研院與得標廠商正式簽訂之「讓與契約書」為準。工研院保留與得標廠商簽訂「讓與契約書」之權利。
2. 得標廠商如屆期末與工研院簽訂「讓與契約書」時，工研院得沒收簽約保證金並取消得標資格（但經工研院同意者，不在此限）；此外，工研院得另洽第三人為授權或讓與等交易行為，第三人不限於本公告之投標廠商資格。
3. 得標廠商與簽訂「讓與契約書」者，須為同一人，否則工研院得沒收簽約保證金並取消得標資格；此外，工研院得另洽第三人為授權或讓與等交易行為，第三人不限於本公告之投標廠商資格。
4. 得標廠商就「讓與標的」同意遵守中華民國相關法令之規定（包括但不限於介入權、境外實施等規定）。前述法令變動時，亦同。
5. 得標廠商取得「讓與標的」應支付工研院讓與費用，讓與費用應以現金支付，但經工研院事前書面同意，得標廠商得以其股票支付，惟其支付方式、內容及相關細節等均應符合工研院之要求。
6. 得標廠商簽署「讓與契約書」且生效時，本標案簽約保證金移充為「讓與契約書」之讓與費用。
7. 「讓與契約書」中之科專成果之讓與，須報經濟部同意後生效。另，得標廠商充分了解「共有標的」之讓與，須經共有人同意。此外，工研院對於共有人及經濟部之意見並無影響能力。
8. 得標廠商同意經濟部及工研院就「讓與標的」，享有永久、無償、全球、非專屬及不可轉讓之使用、實施其全部或部份之權利。得標廠商嗣後若將「讓與標的」專屬授權或讓與第三人時，並應使該第三人同意本條約定。再為專屬授權或讓與時亦同。
9. 得標廠商應就「讓與標的」之一部或全部，承受於「讓與契約書」生效前：1.工研院已與第三人簽訂之授權契約；2.工研院已承諾第三人未來得取得非專屬授權之權利；及 3.工研院已承諾不會對特定之人行使專利權。得標廠商嗣後若將「讓與標的」專屬授權或讓與他人時，並應使該專屬被授權人或受讓人同意本條約定。前述受讓人再為專屬授權或讓與時亦同。

10. 得標廠商同意並承認，「讓與契約書」僅為工研院同意讓與「讓與標的」予得標廠商。工研院亦僅依本標案公告日之「讓與標的」現狀辦理本標案並交付得標廠商，工研院不擔保「讓與標的」之尚在申請中之專利可獲證，或可依原始申請範圍獲證，或已獲證專利不會被撤銷、消滅或其範圍不會變更。工研院亦不擔保「讓與標的」有效性、合用性、商品化、無瑕疵、得向第三人主張權利、不侵害第三人之智慧財產權及可達其他特定目的之可能性，且不擔保得標廠商利用「讓與標的」所製造產品之產品責任。「讓與標的」之未獲證或被撤銷，工研院毋須返還或賠償任何款項予得標廠商。得標廠商或第三人因「讓與標的」發生任何損害時，工研院無須負擔任何責任，包括無須負擔相關侵權與瑕疵擔保責任。「讓與契約書」生效後，「讓與標的」之任何舉發、被撤銷或其他糾紛，得標廠商同意自行負責，概與工研院無涉；工研院亦毋須返還或賠償任何款項予得標廠商。此外，工研院並無提供任何有關「讓與標的」之資料文件予得標廠商，或是對得標廠商提供有關「讓與標的」之諮詢講解或訓練之義務。
11. 「讓與標的」之讓與登記手續由得標廠商負責辦理，並由得標廠商負擔讓與手續所需之一切費用。雙方將互相配合以辦理讓與登記所需之手續。得標廠商應自「讓與契約書」生效之日起負擔「讓與標的」之申請維護等相關費用；得標廠商未依規定自行繳費，因而致「讓與標的」發生失效或其他不利益之效果者，概由得標廠商自負其責，工研院毋須為得標廠商之利益繳交專利相關費用或行使任何專利法所規定之權利義務。
12. 「讓與標的」有以下情事之一者，得標廠商同意遵守相關之法令規定，配合工研院為一切必要之申請，並應將其檢視該專利運用行為是否可能導致我國核心競爭力之削弱或影響國內研發創新佈局之報告，事前提供工研院。得標廠商且應配合工研院向主管機關(包含但不限經濟部技術處，以下同)及立法院經濟委員會為境外實施等一切必要之申請(包括但不限於境外實施之申請等)，並應提供一切相關之文件。得標廠商應於取得工研院及/或主管機關及/或立法院經濟委員會核准及同意後始得為之：
- (1) 得標廠商在我國管轄區域(係指台、澎、金、馬，下同)外自行使用、實施者；
 - (2) 得標廠商非專屬授權供非我國研究機構或企業，或在我國管轄區域外製造或使用；
 - (3) 得標廠商專屬授權供非我國研究機構或企業，或在我國管轄區域外製造或使用；
 - (4) 得標廠商讓與「讓與標的」之對象非我國研究機構或企業者。

13.得標廠商如有下列各款情事之一時，經濟部或工研院得終止「讓與契約書」，並得將「讓與標的」非專屬授權他人實施，或於必要時將「讓與標的」中之科專成果收歸國有：

(1)得標廠商於合理時間內無正當理由未有效運用「讓與標的」中之科專成果，且他人曾於該期間內以合理之商業條件，請求授權仍不能達成協議者。

(2)得標廠商以妨礙環境保護、公共安全或公共衛生之方式實施「讓與標的」中之科專成果者。

(3)為增進國家重大利益者。

有前項情形時，工研院已收取得標廠商之各項費用或金額無須返還，亦無須負擔損害賠償責任。

14. 得標廠商如將「讓與標的」之全部或一部授權或讓與第三人（以下稱「後手」）時，應將相關授權或讓與對象事前通知工研院，以便工研院向主管機關陳報運用所生之產業效益。

15.得標廠商應使所有「後手」遵守本條第 8 項至第 10 項、第 12 項至第 14 項、及第 16 項之約定。如「後手」違反前述約定者，視為得標廠商違反前述約定。「後手」再為授權或讓與時，亦同。

16.基於尊重智慧財產並維護合法授權者之權利，得標廠商欲對依中華民國法律設立之法人或中華民國國民就「讓與標的」主張其權利時，應先定合理期間且以合理之商業條件通知該對象請求協商授權事宜。如經前述協商程序仍不能達成協議，而有必要採取法律行動時，應通知工研院。得標廠商於「讓與契約書」生效後對第三人就「讓與標的」以任何方式主張權利時，得標廠商應自行為該行為、進行該程序或訴訟，工研院無參與得標廠商進行該行為、程序或訴訟之義務。

十一、領標方式：

有意投標者，請與工研院「技轉法律中心」聯絡人（請詳十三、聯絡方式）聯絡，取得投標單。

十二、注意事項：

本標案公告為「讓與契約書」之一部分。投標廠商之投標行為，視為已充分閱讀、了解並同意本公告、「讓與標的」、投標單及相關資訊之內容。各該內容如有不清楚或牴觸者，工研院保留最終之解釋與決定權利。

十三、聯絡方式：本公告相關問題請洽詢：工研院「技轉法律中心」 林小姐
電話：(03) 591-6636，傳真：(03) 582-0466

電子信箱：iris.lin@itri.org.tw

地址：31057 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室

附件：讓與標的清單 (154 案 288 件)

專利技術	案次	件次	件編號	中文專利名稱	國家	狀態	專利證號/ 申請案號	專利 起期	專利 迄期	科專/ 自有	種類	契約運用
電容觸控 技術 (6 案 12 件)	1	1	P03940065TW	軟性基板的支撐方法與可撓曲顯示器 的製造方法	台灣	獲證	I278694	2007 0411	2025 0919	科專	發明	
		2	2	P51010100CN	觸控結構及其製造方法	中國	獲證	ZL201210531987.0	2017 0301	2032 1210	科專	發明
	3		P51010100TW	台灣		獲證	I522855	2016 0221	2032 1107	科專	發明	
	4		P51010100US	美國		獲證	9,052,789	2015 0609	2034 0128	科專	發明	
	3	5	P51020064TW	觸控面板及其製造方法	台灣	獲證	I612448	2018 0121	2033 1219	科專	發明	
		6	P51020064US		美國	獲證	9,448,672	2016 0920	2034 0223	科專	發明	
	4	7	P51020066TW	觸控面板及其製造方法以及觸控顯示 面板	台灣	獲證	I520026	2016 0201	2033 1218	科專	發明	
		8	P51020066US	投射式電容觸控面板結構及其製作方 法	美國	獲證	9,606,679	2017 0328	2034 1208	科專	發明	
	5	9	P51980088TW	銅板印刷裝置、銅板印刷機台與其印刷 方法	台灣	獲證	I372117	2012 0911	2029 1215	科專	發明	
	6	10	P51980134CN	觸控面板捲及其製造方法	中國	獲證	ZL201010129366.0	2013 0821	2030 0307	自有	發明	曾非專屬
		11	P51980134TW		台灣	獲證	I465794	2014 1221	2030 0207	自有	發明	曾非專屬
		12	P51980134US		美國	獲證	8,153,920	2012 0410	2030 1117	自有	發明	曾非專屬
影像技術 (23 案 37 件)	7	13	P08930072TW	全畫面運動向量估測的方法	台灣	獲證	I254216	2006 0501	2024 1229	科專	發明	
		8	P08940008TW	共用動態估測的方法及裝置	台灣	獲證	I260928	2006 0821	2025 0505	科專	發明	
	9	15	P51950196TW	可自動偵測對焦區域之影像擷取裝置 及其方法	台灣	獲證	I336589	2011 0121	2027 0626	科專	發明	
	10	16	084890107TW	單鏡頭瞬間三次元取像裝置	台灣	獲證	I39230	2001 0801	2020 1211	科專	發明	
		17	084890107US		美國	獲證	6,580,557	2003 0617	2021 0620	科專	發明	

專利技術	案次	件次	件編號	中文專利名稱	國家	狀態	專利證號/ 申請案號	專利起期	專利迄期	科專/ 自有	種類	契約運用
影像技術 (23 案 37 件)	11	18	084890128TW	單鏡頭三次元瞬間取像裝置及其方法	台灣	獲證	154398	2002 0411	2021 0222	科專	發明	
	12	19	084900054CN	雙軸向調變影像放大倍率的形狀測定裝置	中國	獲證	ZL02103426.5	2005 0406	2022 0204	科專	發明	曾非專屬、非專屬授權中
		20	084900054TW		台灣	獲證	201010	2004 0421	2021 1206	科專	發明	曾非專屬、非專屬授權中
		21	084900054US		美國	獲證	6,574,050	2003 0603	2022 0426	科專	發明	曾非專屬、非專屬授權中
	13	22	084910027TW	適用於校正雷射三次元量測器之方法及裝置	台灣	獲證	191497	2003 1111	2022 0821	科專	發明	曾非專屬、非專屬授權中
		23	084910027US		美國	獲證	7,274,469	2007 0925	2024 0510	科專	發明	非專屬授權中
	14	24	084910031CN	以特徵線分割重建規則化三維模型的方法	中國	獲證	ZL02146355.7	2006 0412	2022 1023	科專	發明	
		25	084910031TW		台灣	獲證	194398	2004 0101	2022 0926	科專	發明	曾非專屬
	15	26	114890061TW	建構漸進式模型的方法	台灣	獲證	159584	2002 0701	2021 0313	科專	發明	曾非專屬
	16	27	P08920015CN	三維模型的階層式紋理貼圖處理方法	中國	獲證	ZL03123872.6	2006 0927	2023 0522	科專	發明	
		28	P08920015TW		台灣	獲證	206727	2004 0621	2023 0515	科專	發明	曾非專屬
	17	29	P08920016CN	三維彩色信息擷取方法及其裝置	中國	獲證	ZL03146273.1	2008 0507	2023 0706	科專	發明	
		30	P08920016TW		台灣	獲證	I257072	2006 0621	2023 0619	科專	發明	曾非專屬
		31	P08920016US		美國	獲證	7,415,151	2008 0819	2026 0217	科專	發明	
	18	32	P08920037CN	建構三維規則化彩色模型的方法	中國	獲證	ZL200310100406.9	2007 0131	2023 1014	科專	發明	
		33	P08920037TW		台灣	獲證	I267799	2006 1201	2023 0918	科專	發明	
	19	34	P08930062TW	立體材質量測之取像平台及校正補償方法	台灣	獲證	I258716	2006 0721	2024 1115	科專	發明	
	20	35	P08940030TW	利用平面過濾限制之快速影像空間間	台灣	獲證	I273509	2007	2025	科專	發明	

專利技術	案次	件次	件編號	中文專利名稱	國家	狀態	專利證號/ 申請案號	專利 起期	專利 迄期	科專/ 自有	種 類	契約運用	
影像技術 (23 案 37 件)				係建構方法				0211	0912				
		36	P08940030US		美國	獲證	7,751,613	2010 0706	2029 0505	科專	發明		
	21	37	P08940084TW	三維人臉辨識系統及其方法	台灣	獲證	1318756	2009 1221	2025 1228	科專	發明		
		38	P08940084US		美國	獲證	7,620,217	2009 1117	2028 0623	科專	發明		
	22	39	P51950109TW	多鏡頭組影像掃描器	台灣	獲證	1301192	2008 0921	2026 1121	科專	發明		
	23	40	P51950110TW	影像填補方法及其機器可讀取媒體	台灣	獲證	1324756	2010 0511	2026 1121	科專	發明		
	24	41	P51950128TW	基於三維空間之特徵點比對、演化與追蹤方法	台灣	獲證	1321297	2010 0301	2026 0928	科專	發明		
	25	42	P51950175TW	解決遮蔽主體影像之三維擬真貼圖模型建構的方法	台灣	獲證	1331731	2010 1011	2026 1226	科專	發明		
	26	43	P51960125TW	重建三維模型的方法	台灣	獲證	1346309	2011 0801	2027 1220	科專	發明		
		44	P51960125US		美國	獲證	8,081,183	2011 1220	2030 1019	科專	發明		
	27	45	P51050039CN	三維顯示模組	中國	審查 中	201611020259.8				科專	發明	
		46	P51050039TW		台灣	獲證	1603135	2017 1021	2036 1012	科專	發明		
		47	P51050039US		美國	審查 中	15/372,409				科專	發明	
	28	48	P08920080TW	海島型噴絲板之檢測裝置	台灣	獲證	1226451	2005 0111	2023 1202	自有	發明	曾非專屬、非專屬授權中	
29	49	P08940066USC1	照明亮度色彩控制系統及其方法	美國	獲證	7,781,990	2010 0824	2026 1222	科專	發明			
半導體元 件技術 (29 案 33 件)	30	50	P07950013TW	光柵線寬粗糙度之關聯方法及其量測方法	台灣	獲證	1305826	2009 0201	2026 1212	科專	發明		
		51	P07950013US	美國	獲證	7,430,052	2008 0930	2027 0423	科專	發明			
	31	52	P51000112US	溝槽式金氧半導體電晶體元件及其製造方法	美國	獲證	8,835,935	2014 0916	2032 0721	科專	發明	非專屬授權中	

專利技術	案次	件次	件編號	中文專利名稱	國家	狀態	專利證號/ 申請案號	專利 起期	專利 迄期	科專/ 自有	種 類	契約運用
半導體元件技術 (29案33件)	32	53	P51000135US	碳化矽溝槽式蕭基能障元件	美國	獲證	8,766,279	2014 0701	2033 0108	科專	發明	
	33	54	P51010017US	雙凹溝槽式蕭基能障元件	美國	獲證	8,878,327	2014 1104	2032 1227	科專	發明	
	34	55	P51010038US	用於多圖案化的減光型相位移光罩	美國	獲證	8,691,478	2014 0408	2032 0921	科專	發明	
	35	56	P51010081US	蕭基能障二極體及其製造方法	美國	獲證	8,956,963	2015 0217	2033 0701	科專	發明	
	36	57	P51010109US	階梯溝槽式金氧半場效電晶體及其製造方法	美國	獲證	8,841,721	2014 0923	2033 0506	科專	發明	非專屬授權中
	37	58	P51970083US	三維積體電路之直通矽晶穿孔製程監控方法及裝置	美國	獲證	8,219,340	2012 0710	2030 0913	科專	發明	
	38	59	P51980152US	製程偏移偵測裝置與製程偏移偵測方法	美國	獲證	8,392,132	2013 0305	2031 0513	科專	發明	
	39	60	P51990059US	多晶片堆疊結構	美國	獲證	8,581,419	2013 1112	2031 0919	科專	發明	非專屬授權中
	40	61	P51000001US	非揮發性靜態隨機存取式記憶體胞以及記憶體電路	美國	獲證	8,508,983	2013 0813	2031 0912	科專	發明	
	41	62	P51000002US	記憶體單元	美國	獲證	8,642,985	2014 0204	2031 1128	科專	發明	
	42	63	P51000008US	電阻式記憶體及其寫入驗證方法	美國	獲證	8,750,016	2014 0610	2032 1204	科專	發明	
	43	64	P51000023US	磁性移位暫存器的讀取器	美國	獲證	8,467,222	2013 0618	2031 1029	科專	發明	
	44	65	P51000034US	非揮發性記憶體的寫入時序控制電路和控制方法	美國	獲證	8,625,361	2014 0107	2032 0301	科專	發明	
	45	66	P51000047US	非揮發性記憶體結構及其製造方法	美國	獲證	8,624,218	2014 0107	2032 0109	科專	發明	
	46	67	P51000073US	非揮發性隨機存取記憶體及其操作方法	美國	獲證	8,422,295	2013 0416	2031 1220	科專	發明	
	47	68	P51010056US	磁性裝置	美國	獲證	8,901,687	2014 1202	2032 1126	科專	發明	
	48	69	P51010154US	記憶體儲存電路及驅動記憶體儲存電路之方法	美國	獲證	8,942,027	2015 0127	2033 0709	科專	發明	
	49	70	P51970014TW	相變化記憶體元件	台灣	獲證	1489667	2015	2028	科專	發明	共有

專利技術	案次	件次	件編號	中文專利名稱	國家	狀態	專利證號/ 申請案號	專利起期	專利迄期	科專/ 自有	種類	契約運用	
半導體元件技術 (29 案 33 件)								0621	1214				
		71	P51970014US		美國	獲證	7,906,774	2011 0315	2028 0807	科專	發明	共有	
		50	72	P51980067US	控制方法	美國	獲證	8,223,528	2012 0717	2030 0602	科專	發明	非專屬授權中
			73	P51980067USC1		美國	獲證	8,817,521	2014 0826	2030 0415	科專	發明	非專屬授權中
		51	74	P51980077US	電阻切換式記憶體	美國	獲證	8,198,620	2012 0612	2030 0926	科專	發明	非專屬授權中
		52	75	P51990002US	非揮發性靜態隨機存取記憶體及其操作方法	美國	獲證	8,331,134	2012 1211	2031 0512	科專	發明	
		53	76	P51990009US	磁性隨機存取記憶體	美國	獲證	8,421,171	2013 0416	2031 0810	科專	發明	
		54	77	P51980104US	具有光能轉換的電聲裝置	美國	獲證	8,831,253	2014 0909	2031 0818	科專	發明	
		55	78	P51980137CN	具有散熱結構之平面式揚聲器及平面揚聲器的散熱方法	中國	獲證	ZL201010163201.5	2014 0409	2030 0413	科專	發明	
			79	P51980137US	具有散熱結構之平面式揚聲器裝置以及平面揚聲器之散熱方法	美國	獲證	8,447,053	2013 0521	2031 0421	科專	發明	
		56	80	P51990057US	平面揚聲器的驅動介面裝置	美國	獲證	8,588,438	2013 1119	2031 0915	科專	發明	
		57	81	P51000148US	應用穿隧式磁電阻器之磁場感測方法及磁場感測裝置	美國	獲證	8,816,683	2014 0826	2033 0217	自有	發明	曾非專屬、非專屬授權中
		58	82	P51000153US	穿隧磁阻參考單元以及使用此穿隧磁阻參考單元之磁場感測電路	美國	獲證	8,957,487	2015 0217	2032 1217	自有	發明	曾非專屬、非專屬授權中
半導體封裝技術 (15 案 36 件)		59	83	034900053US	增益型晶圓級構裝之結構及其製造方法	美國	獲證	6,914,333	2005 0705	2023 0508	科專	發明	
			84	P03920074TW	晶圓級構裝結構及其製造方法	台灣	獲證	I224377	2004 1121	2023 1113	科專	發明	
		60	85	P03920074US		美國	獲證	6,998,718	2006 0214	2024 0428	科專	發明	
			86	P03920074USC1		美國	獲證	8,039,935	2011 1018	2025 0617	科專	發明	
		61	87	P03940024CN	具有梁柱結構之三維晶片堆疊結構及三維晶片堆疊的方法	中國	獲證	ZL200510120396.4	2009 0603	2025 1110	自有	發明	

專利技術	案次	件次	件編號	中文專利名稱	國家	狀態	專利證號/ 申請案號	專利起期	專利迄期	科專/ 自有	種類	契約運用
半導體封裝技術 (15案36件)	62	88	P03940024TW	具探柱結構之三维晶圓堆疊架構	台灣	獲證	I285419	2007 0811	2025 1025	自有	發明	
		89	P03940024US		美國	獲證	8,164,165	2012 0424	2029 0628	自有	發明	
		90	P03940024USC1		美國	獲證	8,810,031	2014 0819	2026 1227	自有	發明	
		91	P03940024USD2		美國	獲證	9,111,774	2015 0818	2026 0619	自有	發明	
	62	92	P51960062TW	具有靜電放電防護之基板及積體電路	台灣	獲證	I366909	2012 0621	2027 1014	科專	發明	
		93	P51960062US		美國	獲證	7,649,723	2010 0119	2028 0311	科專	發明	
	63	94	P51960084TW	晶片結構及其製程與覆晶封裝結構及其製程	台灣	獲證	I397978	2013 0601	2027 1211	科專	發明	
	64	95	P51970061TW	發光裝置與其製造方法	台灣	獲證	I447892	2014 0801	2029 0419	科專	發明	
		96	P51970061US		美國	獲證	8,310,037	2012 1113	2031 0205	科專	發明	
	65	97	P51970072CN	電路板結構及其製造方法	中國	獲證	ZL200810149489.3	2011 1207	2028 0917	科專	發明	
		98	P51970072TW		台灣	獲證	I387417	2013 0221	2028 0828	科專	發明	
		99	P51970072US		美國	獲證	8,288,655	2012 1016	2030 0625	科專	發明	
	66	100	P51970133TW	多組同軸導線於基材之單一通孔中之結構與其製作方法	台灣	獲證	I393490	2013 0411	2028 1230	科專	發明	
		101	P51970133US		美國	獲證	8,304,666	2012 1106	2030 0819	科專	發明	
	67	102	P51950016TW	互補鏡像式內藏平面電阻架構	台灣	獲證	I370708	2012 0811	2026 1019	自有	發明	
103		P51950016US	美國		獲證	8,035,036	2011 1011	2029 0418	自有	發明		
68	104	P51970101CN	電容結構	中國	獲證	ZL200910173551.7	2013 0102	2029 0914	科專	發明		
	105	P51970101TW		台灣	獲證	I467610	2015	2029	科專	發明		

專利技術	案次	件次	件編號	中文專利名稱	國家	狀態	專利證號/ 申請案號	專利 起期	專利 迄期	科專/ 自有	種 類	契約運用	
半導體封裝技術 (15 案 36 件)								0101	0722				
		106	P51970101US		美國	獲證	8,488,299	2013 0716	2031 0525	科專	發明		
	69	107	034900080US	光電模組模封裝	美國	獲證	7,004,642	2006 0228	2023 1221	科專	發明		
		108	P03940138TW	熱管式發電元件	台灣	獲證	1275757	2007 0311	2026 0104	自有	發明		
	70	109	P03940138TWC1	熱管式發電元件、熱發電裝置、熱能回收裝置	台灣	獲證	1387685	2013 0301	2026 1219	自有	發明		
		110	P03940138US	熱管式發電元件	美國	獲證	8,283,613	2012 1009	2030 0501	自有	發明		
	71	111	P51950064CN	射頻識別標籤系統及其標籤	中國	獲證	ZL200610149880.4	2011 0413	2026 1026	科專	發明		
		112	P51950064TW	射頻辨識標籤系統及其資料串流	台灣	獲證	1324320	2010 0501	2026 0831	科專	發明		
		113	P51960146CN	存儲器電容的電極結構以及存儲器電容結構的製造方法	中國	獲證	ZL200810085490.4	2011 0713	2028 0318	科專	發明		
	72	114	P51960146TW	記憶體電容的電極結構及其製造方法	台灣	獲證	1482209	2015 0421	2028 0304	科專	發明		
		115	P51960146US		美國	獲證	7,999,350	2011 0816	2029 0302	科專	發明		
		116	P51970095CN	射頻識別標籤天線、標籤裝置及通信系統	中國	獲證	ZL200910004122.7	2013 0417	2029 0211	科專	發明		
	73	117	P51970095TW	無線電識別(RFID)標籤天線、標籤裝置及通訊系統	台灣	獲證	1379456	2012 1211	2028 1210	科專	發明		
		118	P51970095US	無線電識別(RFID)標籤天線、標籤裝置及通訊系統	美國	獲證	8,319,610	2012 1127	2031 0523	科專	發明		
	半導體光源技術 (18 案 37 件)	74	119	084890084TW	積體化面射型光電模組及其製作方法	台灣	獲證	139437	2001 0811	2020 0921	科專	發明	
			120	084890084US		美國	獲證	6,511,235	2003 0128	2020 1218	科專	發明	
		75	121	P08930013TW	微型晶體光纖雷射及倍頻晶體光纖之製造方法	台灣	獲證	1233248	2005 0521	2024 0629	科專	發明	
			122	P08930013US		美國	獲證	7,630,415	2009 1208	2026 0212	科專	發明	

專利技術	案次	件次	件編號	中文專利名稱	國家	狀態	專利證號/ 申請案號	專利起期	專利迄期	科專/ 自有	種類	契約運用	
半導體光源技術 (18案37件)	76	123	P08930071TW	垂直共振腔面射型雷射	台灣	獲證	I242919	2005 1101	2024 1226	科專	發明		
	77	124	P08930104TW	發光二極體封裝結構及其製作方法	台灣	獲證	I239670	2005 0911	2024 1228	科專	發明	非專屬授權中	
		125	P08930104US		美國	獲證	7,521,724	2009 0421	2026 0601	科專	發明	非專屬授權中	
	78	126	P08930119TW	動態光功率等化器	台灣	獲證	I258605	2006 0721	2024 1221	科專	發明		
		127	P08930119US		美國	獲證	7,003,195	2006 0221	2025 0405	科專	發明		
	79	128	P08940012TW	雙向光收發次模組	台灣	獲證	I267254	2006 1121	2025 0911	科專	發明		
	80	129	P51040014CN	殺菌裝置	中國	審查 中	201510844916.X				科專	發明	
		130	P51040014TW		台灣	獲證	I565487	2017 0111	2035 0924	科專	發明	非專屬授權中	
		131	P51040014US		美國	獲證	9,566,358	2017 0214	2035 1202	科專	發明		
	81	132	P51040024CN	筷子收納盒	中國	獲證	ZL201520871435.3	2016 0420	2025 1103	科專	新型		
		133	P51040024TW		台灣	獲證	M515341	2016 0111	2025 0920	科專	新型		
	82	134	P51050003TW	容器之部分	台灣	獲證	D179237	2016 1101	2028 0330	科專	設計		
		135	P51050003US		美國	獲證	D801,181	2017 1031	2032 1031	科專	設計		
	83	136	P51050005CN	殺菌容器	中國	獲證	ZL201630323522.5	2017 0104	2026 0714	科專	設計		
		137	P51050005TW	殺菌容器之部分	台灣	獲證	D180200	2016 1221	2028 0328	科專	設計		
		138	P51050005US	殺菌容器	美國	獲證	D807,524	2018 0109	2033 0108	科專	設計		
	84	139	P51050044CN	便攜式殺菌裝置	中國	獲證	ZL201720036456.2	2018 0116	2027 0111	科專	新型		
		140	P51050044TW	可攜式殺菌裝置	台灣	獲證	M536063	2017	2026	科專	新型		

專利技術	案次	件次	件編號	中文專利名稱	國家	狀態	專利證號/ 申請案號	專利 起期	專利 迄期	科專/ 自有	種類	契約運用		
半導體光源技術 (18案37件)								0201	1101					
	85	141	P51060033CN	流體殺菌裝置及應用其的淨水設備	中國	審查中	201810052751.6				科專	發明		
		142	P51060033TW	殺菌裝置	台灣	審查中	106146181				科專	發明		
		143	P51060033US	殺菌裝置	美國	審查中	15/940,552				科專	發明		
	86	144	P51950006CN	照明裝置及其技術結構	中國	獲證	ZL200610094189.0	2010 0915	2026 0626		科專	發明		
		145	P51950006TW		台灣	獲證	I270628	2007 0111	2026 0613		科專	發明		
	87	146	P51950007TW	發光裝置	台灣	獲證	I319628	2010 0111	2026 0620		科專	發明	非專屬授權中	
	88	147	P51950038CN	照明裝置	中國	獲證	ZL200610135596.1	2009 1007	2026 1017		科專	發明		
		148	P51950038TW		台灣	獲證	I299311	2008 0801	2026 0926		科專	發明		
		149	P51950038US		美國	獲證	8,029,160	2011 1004	2026 1121		科專	發明		
	89	150	P51950039TW	半導體發光元件的基板及其製造方法	台灣	獲證	I304278	2008 1211	2026 0615		科專	發明	非專屬授權中	
		151	P51950039US		美國	獲證	7,427,772	2008 0923	2026 0905		科專	發明	非專屬授權中	
	90	152	P51950070TW	半導體雷射結構及其形成方法	台灣	獲證	I352470	2011 1111	2026 1120		科專	發明		
	91	153	P51960040CN	微芯片陣陣式光源模組	中國	獲證	ZL200810145000.5	2010 1013	2028 0817		科專	發明		
		154	P51960040TW	微晶片陣陣式光源模組	台灣	獲證	I363438	2012 0501	2028 0714		科專	發明		
		155	P51960040US		美國	獲證	7,651,254	2010 0126	2027 1224		科專	發明		
	平面顯示器 (有機發光顯示) (32案68件)	92	156	034890121TW	雙基板主動式有機發光顯示器	台灣	獲證	171074	2002 1221	2021 1007		科專	發明	曾非專屬、共有
			157	P03930032TW	上發光型有機發光二極體畫素之製程與結構	台灣	獲證	I238020	2005 0811	2024 0825		科專	發明	

專利技術	案次	件次	件編號	中文專利名稱	國家	狀態	專利證號/ 申請案號	專利起期	專利迄期	科專/ 自有	種類	契約運用
平面顯示器(有機發光顯示) (32案68件)	94	158	P03930056TW	上發光有機發光元件	台灣	獲證	I240593	2005 0921	2024 1014	科專	發明	共有
	95	159	P03940041CN	驅動有機發光二極管的薄膜晶體管及其製造方法	中國	獲證	ZL200510080490.1	2009 0408	2025 0704	科專	發明	
		160	P03940041TW	驅動有機發光二極體之薄膜電晶體及其製造方法	台灣	獲證	I258221	2006 0711	2025 0627	科專	發明	
	96	161	P03940232CN	有機發光二極管整合彩色濾光片接觸電阻的結構及方法	中國	獲證	ZL200610067443.8	2010 0127	2026 0326	科專	發明	
		162	P03940232TW	改善有機發光二極體整合彩色濾光片接觸電阻之結構及方法	台灣	獲證	I298234	2008 0621	2026 0222	科專	發明	
	97	163	P03940233CN	有機發光二極管整合彩色濾光片影像品質改善結構及方法	中國	獲證	ZL200610057672.1	2009 0506	2026 0223	科專	發明	
		164	P03940233TW	改善有機發光二極體整合彩色濾光片影像品質之結構及方法	台灣	獲證	I290382	2007 1121	2026 0209	科專	發明	
	98	165	P03940299TW	使用積層式彩色濾光片之有機發光元件結構及其製作方法	台灣	獲證	I267213	2006 1121	2026 0126	科專	發明	
	99	166	P08930069CN	有機高分子發光二極管裝置及其應用的顯示器	中國	獲證	ZL200510002328.8	2008 1112	2025 0116	科專	發明	共有
		167	P08930069TW		台灣	獲證	I305113	2009 0101	2024 1229	科專	發明	共有
	100	168	P08930083TW	彩色有機電激發光顯示器及其製程	台灣	獲證	I254594	2006 0501	2025 0316	科專	發明	共有
		169	P08930083US		美國	獲證	7,619,243	2009 1117	2027 0605	科專	發明	共有
	101	170	P61000046CN	發光組件	中國	獲證	ZL201210075693.1	2016 0817	2032 0318	科專	發明	共有
		171	P61000046TW	發光元件	台灣	獲證	I470849	2015 0121	2032 0119	科專	發明	曾非專屬、共有
		172	P61000046US		美國	獲證	8,878,226	2014 1104	2033 0116	科專	發明	共有
	102	173	P61000063CN	雙面發光顯示面板	中國	獲證	ZL201210055693.5	2015 1104	2032 0306	科專	發明	共有
		174	P61000063TW		台灣	獲證	I478333	2015 0321	2032 0129	科專	發明	曾非專屬、共有
		175	P61000063US	雙面發光顯示面板	美國	獲證	9,041,280	2015	2033	科專	發明	共有

專利技術	案次	件次	件編號	中文專利名稱	國家	狀態	專利證號/ 申請案號	專利起期	專利迄期	科專/ 自有	種類	契約運用
平面顯示器(有機發光顯示) (32案68件)								0526	0128			
	103	176	P61990006TW	發光裝置及其製造方法	台灣	獲證	I397178	2013 0521	2030 0909	科專	發明	共有
		177	P61990006US		美國	獲證	8,368,088	2013 0205	2031 0803	科專	發明	共有
	104	178	P61010057TW	電子元件之封裝結構	台灣	獲證	I552331	2016 1001	2033 0110	科專	發明	共有
		179	P61010057USD1		美國	獲證	9,795,028	2017 1017	2033 0701	科專	發明	共有
	105	180	P61010065CN	環境敏感電子元件封裝體及其製作方法	中國	獲證	ZL201310047427.2	2016 0817	2033 0205	科專	發明	共有
		181	P61010065TW		台灣	獲證	I497655	2015 0821	2032 1213	科專	發明	共有
		182	P61010065US		美國	獲證	9,252,389	2016 0202	2033 1130	科專	發明	共有
		183	P61010065USD1		美國	獲證	9,748,516	2017 0829	2033 0603	科專	發明	共有
	106	184	P61010078CN	環境敏感電子元件封裝體	中國	獲證	ZL201310559674.0	2016 0914	2033 1111	科專	發明	共有
		185	P61010078TW		台灣	審查中	I02140175			科專	發明	共有
	107	186	P61010080TW	環境敏感電子元件封裝體	台灣	獲證	I569437	2017 0201	2033 0516	科專	發明	共有
		187	P61010080TWD1		台灣	獲證	I587502	2017 0611	2033 0516	科專	發明	
		188	P61010080US		美國	獲證	9,565,793	2017 0207	2033 1010	科專	發明	共有
	108	189	P61010089CN	環境敏感電子元件封裝體及其製作方法	中國	獲證	ZL201310625683.5	2017 0426	2033 1127	科專	發明	共有
		190	P61010089TW		台灣	獲證	I536085	2016 0601	2033 0903	科專	發明	共有
		191	P61010089US		美國	獲證	9,510,459	2016 1129	2034 0906	科專	發明	共有
	109	192	P61010091TW	電子元件封裝結構與其製作方法	台灣	獲證	I532128	2016 0501	2033 0627	科專	發明	共有

專利技術	案次	件次	件編號	中文專利名稱	國家	狀態	專利證號/ 申請案號	專利 起期	專利 迄期	科專/ 自有	種類	契約運用
平面顯示器(有機發光顯示) (32案68件)		193	P61010091US	電子元件封裝結構與其製作方法	美國	獲證	9,847,512	2017 1219	2034 0828	科專	發明	共有
	110	194	P61020002CN	環境敏感電子裝置及其封裝方法	中國	獲證	ZL201410012580.6	2017 0412	2034 0109	科專	發明	共有
		195	P61020002TW		台灣	獲證	1512863	2015 1211	2033 0912	科專	發明	共有
		196	P61020002US		美國	獲證	9,681,555	2017 0613	2035 0308	科專	發明	共有
		111	197		P61970061TW	有機發光二極體裝置及其封裝方法	台灣	獲證	1381569	2013 0101	2028 1229	科專
	198		P61970061US	美國	獲證		8,366,505	2013 0205	2031 0104	科專	發明	共有
	112	199	P61990021TW	環境敏感電子元件之封裝體及其封裝方法	台灣	獲證	1443784	2014 0701	2030 0728	科專	發明	共有
		200	P61990021US		美國	獲證	8,624,134	2014 0107	2031 1227	科專	發明	共有
	113	201	P03940033CN	垂直式半自發光半反射式顯示器的像素結構	中國	獲證	ZL200510080525.1	2009 0610	2025 0703	科專	發明	曾專屬
		202	P03940033TW		台灣	獲證	1307438	2009 0311	2025 0630	科專	發明	曾專屬
		203	P03940033US		美國	獲證	7,576,736	2009 0818	2026 0303	科專	發明	曾專屬
	114	204	P03940063CN	垂直式半自發光半反射式顯示器的像素結構及其製造方法	中國	獲證	ZL200510104926.6	2009 0311	2025 0921	科專	發明	曾專屬
		205	P03940063TW	垂直式半自發光半反射式顯示器之像素結構及其製造方法	台灣	獲證	1282708	2007 0611	2025 0802	科專	發明	曾專屬
		206	P03940063US	垂直式半自發光半反射式顯示器之像素結構及其製造方法	美國	獲證	7,599,025	2009 1006	2028 0420	科專	發明	曾專屬
		207	P03940063USD1	美國	獲證	7,482,185	2009 0127	2027 0306	科專	發明	曾專屬	
	115	208	P61000017CN	複合式顯示裝置	中國	獲證	ZL201110351079.9	2015 0617	2031 1031	科專	發明	共有
		209	P61000017TW		台灣	獲證	1449006	2014 0811	2031 1004	科專	發明	共有
	116	210	P61030019TWC1	顯示裝置	台灣	獲證	1576626	2017	2035	科專	發明	共有

專利技術	案次	件次	件編號	中文專利名稱	國家	狀態	專利證號/ 申請案號	專利 起期	專利 迄期	科專/ 自有	種 類	契約運用	
平面顯示器(有機發光顯示) (32案68件)								0401	0518				
		211	P61030019US		美國	獲證	9,547,213	2017 0117	2035 0830	科專	發明	共有	
	117	212	P03940105TW	自動亮度調整方法與裝置以及顯示裝置	台灣	獲證	I325575	2010 0601	2025 1123	科專	發明	共有	
		213	P03940105US		美國	獲證	7,796,143	2010 0914	2029 0529	科專	發明	共有	
	118	214	P08940089CN	顯示器之數字圖像適應性色彩調整方法與裝置	中國	獲證	ZL200510135699.3	2009 0715	2025 1230	科專	發明	共有	
		215	P08940089TW		台灣	獲證	I295895	2008 0411	2025 1229	科專	發明	共有	
	119	216	P61950020CN	色彩調整電路、數字色彩調整裝置與應用其的多媒體裝置	中國	獲證	ZL200610136648.7	2011 0622	2026 1026	科專	發明	共有	
		217	P61950020TW		台灣	獲證	I333383	2010 1111	2026 0924	科專	發明	共有	
		218	P61950020US		美國	獲證	8,319,790	2012 1127	2030 0627	科專	發明	共有	
	120	219	P61950032TW	多頻率動態伽瑪校正系統及其方法	台灣	獲證	I315151	2009 0921	2026 1109	科專	發明	共有	
		220	P61950032US		美國	獲證	8,184,131	2012 0522	2029 0316	科專	發明	共有	
	121	221	P61960005TW	光電性質檢測方法及裝置	台灣	獲證	I351515	2011 1101	2027 0805	科專	發明	曾專屬	
	122	222	P61970036TW	基於亮度/色差色彩空間之分色技術的色序法與使用該方法之顯示裝置	台灣	獲證	I380700	2012 1221	2028 1229	科專	發明	曾專屬	
	123	223	P61970037TW	量測方法及顯示器	台灣	獲證	I385369	2013 0211	2029 0222	科專	發明	曾專屬	
	平面顯示器(薄膜電晶體) (31案65件)	124	224	P51950079TW	整合在單一基板上之電子元件及其製造方法	台灣	獲證	I325744	2010 0601	2026 0827	科專	發明	
			225	P51950079US		美國	獲證	7,781,270	2010 0824	2028 0926	科專	發明	
		125	226	P51980024TW	氧化物半導體薄膜電晶體	台灣	獲證	I397184	2013 0521	2029 0428	科專	發明	共有
227			P51980024US	美國		獲證	8,053,836	2011	2030	科專	發明	共有	

專利技術	案次	件次	件編號	中文專利名稱	國家	狀態	專利證號/ 申請案號	專利起期	專利迄期	科專/ 自有	種類	契約運用
平面顯示器(薄膜電晶體) (31案65件)								1108	0301			
	126	228	P03930180TW	可光感測之顯示單元	台灣	獲證	I253846	2006 0421	2025 0327	科專	發明	共有
		229	P03930180US		美國	獲證	7,532,182	2009 0512	2027 0903	科專	發明	共有
	127	230	P61010014US	顯示器	美國	獲證	9,000,452	2015 0407	2032 0927	科專	發明	共有
	128	231	P61970034TW	感測面板	台灣	獲證	I412974	2013 1021	2028 1126	科專	發明	共有
	129	232	P61980051CN	主動式光感測像素、主動式光感測陣列 以及光感測方法	中國	獲證	ZL201010250735.1	2013 1120	2030 0804	科專	發明	共有
		233	P61980051JP		日本	獲證	5256277	2013 0426	2030 1213	科專	發明	共有
		234	P61980051KR	主動式光感測像素、主動式光感測陣列 以及光感測方法	韓國	獲證	10-1278899	2013 0620	2030 1206	科專	發明	共有
		235	P61980051TW		台灣	獲證	I436137	2014 0501	2030 0614	科專	發明	共有
		236	P61980051US		美國	獲證	8,717,335	2014 0506	2032 1003	科專	發明	共有
	130	237	P61980057TW	主動式光感測像素、主動式光感測陣列 以及光感測方法	台灣	獲證	I418908	2013 1211	2030 0614	科專	發明	共有
		238	P61980057US		美國	獲證	8,723,096	2014 0513	2033 0310	科專	發明	共有
	131	239	P61990001CN	主動式光感測像素、主動式光感測陣列 以及光感測方法	中國	獲證	ZL201010250757.8	2013 0529	2030 0804	科專	發明	共有
		240	P61990001TW		台灣	獲證	I410727	2013 1001	2030 0614	科專	發明	共有
		241	P61990001US		美國	獲證	8,445,829	2013 0521	2031 1104	科專	發明	共有
	132	242	P61990009CN	光電元件、顯示單元及其製造方法、顯示面板	中國	獲證	ZL201010614224.3	2015 0121	2030 1229	科專	發明	共有
		243	P61990009TW		台灣	獲證	I443811	2014 0701	2030 1006	科專	發明	共有
		244	P61990009US		美國	獲證	9,257,590	2016 0209	2034 1020	科專	發明	共有

專利技術	案次	件次	件編號	中文專利名稱	國家	狀態	專利證號/ 申請案號	專利 起期	專利 迄期	科專/ 自有	種 類	契約運用
平面顯示器(薄膜電晶體) (31案65件)	133	245	P61990040CN	光敏電路以及光敏顯示器系統	中國	復證	ZL201010621752.1	2014 0528	2030 1223	科專	發明	共有
		246	P61990040FWC1		台灣	復證	I436322	2014 0501	2030 1206	科專	發明	共有
		247	P61990040US		美國	復證	8,575,530	2013 1105	2031 0901	科專	發明	共有
	134	248	034910030TW	製造主動式塑膠平面顯示器的方法	台灣	復證	I313062	2009 0801	2022 0912	科專	發明	共有
	135	249	P03910071TW	貼合材料層於透明基板上的方法以及形成單晶矽層於透明基板的方法	台灣	復證	200277	2004 0401	2023 0312	科專	發明	共有
	136	250	P03910117JP	元件轉貼之方法	日本	復證	4758603	2011 0610	2023 0908	科專	發明	共有
		251	P03910117TW	元件轉貼之方法	台灣	復證	I221010	2004 0911	2023 0806	科專	發明	共有
	137	252	P03940038TW	防止介電層在撓曲下破裂的導體/介電層/導體結構	台灣	復證	I272648	2007 0201	2025 0630	科專	發明	共有
	138	253	P03940039TW	畫素陣列	台灣	復證	I281586	2007 0521	2025 0912	科專	發明	共有
		254	P03940039US		美國	復證	7,221,012	2007 0522	2026 0220	科專	發明	共有
	139	255	P03940062TW	畫素佈局結構	台灣	復證	I320495	2010 0211	2025 0719	科專	發明	共有
		256	P03940062US		美國	復證	7,495,736	2009 0224	2026 1101	科專	發明	共有
	140	257	P61010098TW	可撓性電子裝置	台灣	復證	I524996	2016 0311	2034 0112	科專	發明	共有
		258	P61010098US		美國	復證	9,345,131	2016 0517	2034 0123	科專	發明	共有
	141	259	P61040018TW	可撓曲元件	台灣	復證	I592065	2017 0711	2036 0502	科專	發明	共有
		260	P61040018US		美國	復證	9,786,790	2017 1010	2036 0306	科專	發明	共有
	142	261	P61970013CN	晶體管陣列下板	中國	復證	ZL200810178806.4	2011 0727	2028 1125	科專	發明	共有
		262	P61970013TW	電晶體陣列下板	台灣	復證	I360011	2012	2028	科專	發明	共有

專利技術	案次	件次	件編號	中文專利名稱	國家	狀態	專利證號/ 申請案號	專利 起期	專利 迄期	科專/ 自有	種類	契約運用
平面顯示器(薄膜電晶體) (31案65件)								0311	1008			
	143	263	P61970014TW	畫素陣列佈局	台灣	獲證	I462284	2014 1121	2028 1229	科專	發明	
	144	264	P61970015TW	顯示器陣列下板	台灣	獲證	I382226	2013 0111	2028 1008	科專	發明	共有
	145	265	P61970025CN	薄膜晶體管	中國	獲證	ZL200810185612.7	2011 1026	2028 1216	科專	發明	共有
		266	P61970025TW	薄膜電晶體	台灣	獲證	I343129	2011 0601	2028 1123	科專	發明	曾非專屬、曾專屬、 共有
		267	P61970025US		美國	獲證	7,812,344	2010 1012	2029 0216	科專	發明	共有
		268	P61970025USD1		美國	獲證	8,373,168	2013 0212	2029 0803	科專	發明	共有
	146	269	P61980011TW	主動元件陣列基板、有機發光二極體顯示器裝置及其製造方法	台灣	獲證	I411105	2013 1001	2029 0928	科專	發明	曾非專屬、曾專屬
	147	270	P03940156CN	薄膜晶體管結構及其製造方法	中國	獲證	ZL200610057177.0	2009 0408	2026 0312	科專	發明	共有
		271	P03940156TW	薄膜電晶體結構及其製造方法	台灣	獲證	I317558	2009 1121	2026 0306	科專	發明	共有
		272	P03940156US		美國	獲證	7,795,683	2010 0914	2027 1003	科專	發明	共有
		273	P03940156USD1		美國	獲證	7,927,929	2011 0419	2026 1120	科專	發明	共有
	148	274	P03940298CN		具有對稱性的薄膜晶體管組件	中國	獲證	ZL200610065479.2	2009 0610	2026 0321	科專	發明
		275	P03940298TW	台灣		獲證	I285434	2007 0811	2026 0316	科專	發明	共有
		276	P03940298US	美國		獲證	7,491,592	2009 0217	2027 0301	科專	發明	共有
	149	277	P03920044JP	薄膜電晶體元件主動層之半導體材料與其製作方法	日本	獲證	5095068	2012 0928	2023 1211	科專	發明	曾非專屬、共有
		278	P03920044TW		台灣	獲證	I221341	2004 0921	2023 0917	科專	發明	曾非專屬、共有
		279	P03920044USD1		美國	獲證	7,666,764	2010 0223	2025 0330	科專	發明	曾非專屬、共有

專利技術	案次	件次	件編號	中文專利名稱	國家	狀態	專利證號/ 申請案號	專利 起期	專利 迄期	科專/ 自有	種 類	契約運用
平面顯示器(薄膜電晶體) (31案65件)	150	280	P61000026TW	半導體元件及其製造方法	台灣	復證	I497689	2015 0821	2031 1201	科專	發明	曾非專屬、共有
		281	P61000026US		美國	復證	9,165,947	2015 1020	2032 0328	科專	發明	共有
		282	P61000026USD1		美國	復證	9,553,176	2017 0124	2032 0322	科專	發明	共有
	151	283	P61000053CN	互補式金屬氧化物半導體元件及其製造方法	中國	復證	ZL201210059206.2	2016 0113	2032 0307	科專	發明	共有
		284	P61000053TW	半導體元件及其製造方法	台灣	復證	I463663	2014 1201	2031 1229	科專	發明	曾非專屬、共有
	152	285	P61010048TW	半導體元件結構及其製造方法	台灣	復證	I508171	2015 1111	2033 0204	科專	發明	共有
	153	286	P61980005TW	主動層堆疊結構及其製造方法及其應用	台灣	復證	I419328	2013 1211	2029 0611	科專	發明	曾非專屬、曾專屬、共有
	154	287	P61980059TW	電晶體及其製造方法	台灣	復證	I443829	2014 0701	2030 0415	科專	發明	曾非專屬、曾專屬、共有
		288	P61980059US		美國	復證	8,928,046	2015 0106	2031 0323	科專	發明	共有